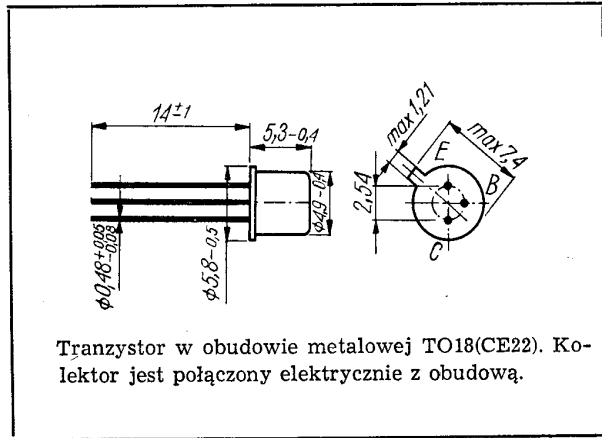


Tranzystory krzemowe epiplanarne przeznaczone do stosowania w układach przełączających małej i średniej mocy. Kolektor tranzystora jest połączony elektrycznie z obudową.



Tranzystor w obudowie metalowej TO18(CE22). Kolektor jest połączony elektrycznie z obudową.

**DANE TECHNICZNE**

**Wartości dopuszczalne parametrów eksploatacyjnych**

Typ		BSYP62	BSYP63	
Napięcie kolektor-baza	$U_{CB0}$	25	40	V
Napięcie kolektor-emiter	$U_{CE0}$	15	15	V
Napięcie emiter-baza	$U_{EB0}$	5	5	V
Prąd kolektora	$I_C$	200	200	mA
Prąd bazy	$I_B$	20	20	mA
Moc strat	$P_C$	360	360	mW
Temperatura złącza	$t_j$	423 K (150°C)		
Zakres temperatury otoczenia	$t_{amb}$	233...373 K (-40...+100°C)		

**TRANZYSTOR BSYP62**

**Parametry statyczne**

przy $t_{amb} = 298$ K (25°C)		min.	maks.
Napięcie przebicia kolektor-baza	$U_{(BR)CB0}$	25	—
przy $I_{CB0} = 10 \mu A$		V	
Napięcie przebicia kolektor-emiter	$U_{(BR)CE0}$	15	—
przy $I_C = 30$ mA		V	
przy $I_C = 30$ mA, $R_{BE} = 10 \Omega$	$U_{(BR)CER}$	20	—
		V	

Napięcie przebicia emiter-baza

przy  $I_{EB0} = 10 \mu A$   $U_{(BR)EB0}$  5 — V

Prąd wsteczny kolektora

przy  $U_{CB0} = 15$  V  $I_{CB0}$  — 500 nA

przy  $U_{CB0} = 15$  V,  $t_{amb} = 373$  K (100°C)  $I_{CB0}$  — 20  $\mu A$

Prąd wsteczny emitera

przy  $U_{EB0} = 4$  V  $I_{EB0}$  — 100 nA

Napięcie nasycenia baza-emiter

przy  $I_C = 10$  mA,  $I_B = 1$  mA  $U_{BEsat}$  — 0,9 V

Napięcie nasycenia kolektor-emiter

przy  $I_C = 10$  mA,  $I_B = 10$  mA  $U_{CEsat}$  — 0,6 V

Współczynnik wzmocnienia prądowego

przy  $I_{C1} = 10$  mA,  $U_{CE} = 1$  V,  $h_{21E}$  20 300 —

przy  $I_C = 10$  mA,  $U_{CE} = 1$  V,  $h_{21E}$  10 — —

przy  $I_C = 10$  mA,  $U_{CE} = 1$  V,  $t_{amb} = 298$  K (-40°C)  $h_{21E}$  10 — —

**Parametry dynamiczne**

przy $t_{amb} = 298$ K (25°C)		min.	maks.
Częstotliwość przeniesienia	$f_T$	200	—
przy $I_C = 20$ mA, $U_{CE} = 10$ V		MHz	
Pojemność kolektora	$C_C$	—	6
przy $U_{CB0} = 10$ V		pF	
Czas włączania	$t_{ON}$	—	40
przy $I_C = 10$ mA, $I_B = 3$ mA, $U_{BE} = 2$ V		ns	
Czas wyłączenia	$t_{OFF}$	—	75
przy $I_C = 10$ mA, $I_{B1} = 3$ mA, $I_{B2} = 1$ mA		ns	

**TRANZYSTOR BSYP63**

**Parametry statyczne**

przy $t_{amb} = 298$ K (25°C)		min.	maks.
Napięcie przebicia kolektor-baza	$U_{(BR)CB0}$	40	—
przy $I_{CB0} = 10 \mu A$		V	

**SWW 1156-223**

